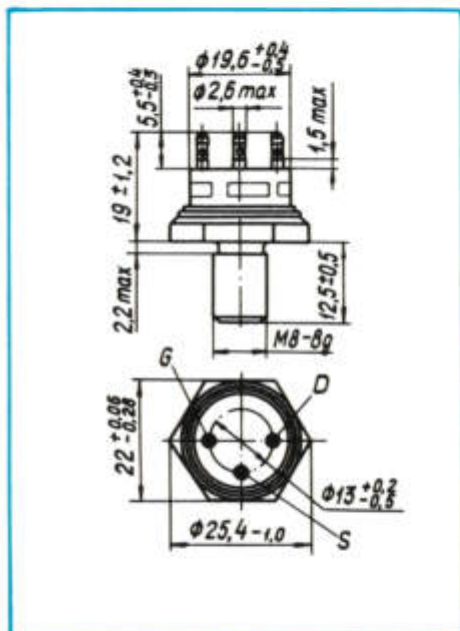


КП904А, КП904Б



ПОЛЕВЫЕ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

LOW POWER HIGH FREQUENCY FETs



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кремниевые планарные полевые n-канальные транзисторы КП904А, КП904Б с изолированным затвором предназначены для генерирования и усиления сигналов КВ и УКВ диапазонов в аппаратуре широкого применения.

Оформление - в металлокерамическом корпусе.

Диапазон допустимых рабочих температур от -60 до +100°С.

GENERAL DESCRIPTION

The КП904А, КП904Б transistors are Silicon planar n-channel insulated-gate field-effect transistors designed for generating and amplifying signals at short and ultrashort waves in a wide range of applications.

The devices are encapsulated in metal-ceramic cases.

Allowable operating temperatures: -60 to +100°С.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ BASIC TECHNICAL CHARACTERISTICS

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ MAXIMUM VALUES OF ALLOWABLE OPERATING CONDITIONS

$U_{DS \max}$	70 V
$U_{GD \max}$	90 V
$U_{GS \max}$	30 V
$U_{DS \max \sim}$	100 V
$U_{GD \max \sim}$	120 V
$P_{DS \max}^x$ ($t_{case} \leq 25^\circ C$)	75 W

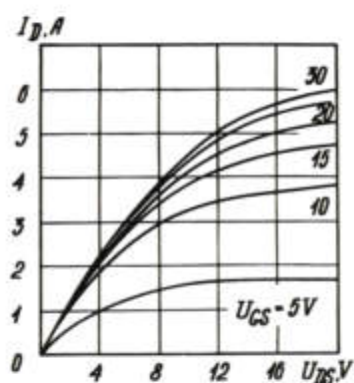
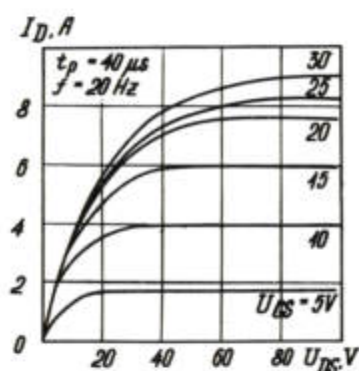
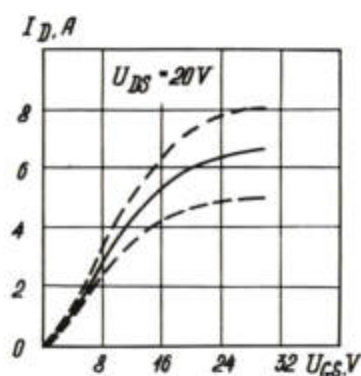
$$\begin{matrix} x_{\text{При}} \\ \text{At} \end{matrix} \quad t_{amb} > 25^\circ C \Rightarrow P_{DS \max} = 75 \left(1 - \frac{t_{case} - 25}{125} \right)$$

~ Динамический режим

КП904А, КП904Б

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ELECTRICAL PARAMETERS

Параметры Parameters	Значения Values	Режимы измерений Measuring conditions		
		$U_{GS}; U_{DS}^x$ V	I_D , mA	f , MHz
g_{ms} , mA/V	> 250	20^x	1000	
I_{DSS} , mA	< 350	$0; 20^x$		
I_{DSX} , mA	< 200	$-20; 100^x$		
I_D , A				
КП904А	> 5	$20; 20^x$		
КП904Б	> 3	$20; 20^x$		
C_{gso} , pF	< 300	-30		1
η , %	< 53	$0; 55^x$		60
G_p	< 25	$0; 55^x$		60

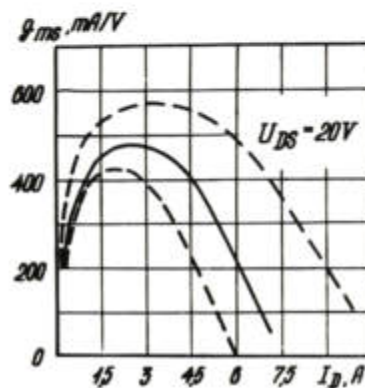
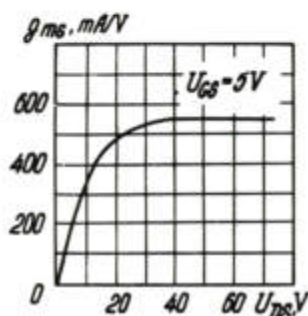
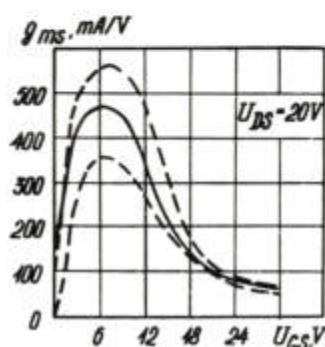


ТИПОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
TYPICAL DEPENDENCE



ГРАНИЦЫ
LIMITS OF **95** % РАЗБРОСА
SPREAD

КП904А, КП904Б

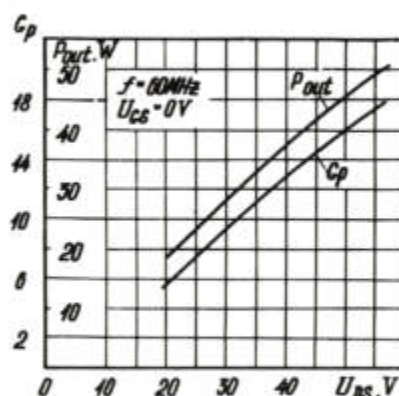


УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пайку выводов допускается производить на расстоянии не менее 1,5 мм от корпуса транзистора. Время пайки не более 3 с. Температура припоя $(235 \pm 5)^\circ C$.

Число допустимых перепаек выводов транзисторов при проведении монтажных операций не более 3.

В процессе эксплуатации запрещается одновременная подача предельных электрических и температурных режимов на транзистор.



OPERATING INSTRUCTIONS

Lead soldering is allowed at a distance of >1.5 from the transistor case. Soldering time must not exceed 3 s. Flux temperature corresponds $(235 \pm 5)^\circ C$.

While mounting the number of lead resoldering processes must not exceed 3.

The transistor is not to be used at maximum ratings of current and temperature applied simultaneously.



ТИПОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
TYPICAL DEPENDENCE



ГРАНИЦЫ
LIMITS OF 95% РАЗБРОСА
SPREAD